ANTIREFLECTION FILE AND PRODUCTION THEREOF

Patent Number:

JP2245702

Publication date:

1990-10-01

Inventor(s):

OKADA RYOJI; others: 03

Applicant(s)::

HITACHI LTD

Requested Patent:

* JP2245702

Application Number: JP19890066193 19890320

Priority Number(s):

IPC Classification: G02B1/10

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain an antireflection film of a large area at a low cost by laminating coating layers different from each other an mixing ratio between the constituents to form a film whose refractive index changes continuously.

CONSTITUTION: A glass substrate, MgF2 as a substance having the lowest refractive index and a substance having a refractive index between the refractive index of the glass substrate and that of MgF2, e.g., SiO2 are prepd. Superfine SiO2 particles 2 are mixed with superfine MgF2 particles 1 and the glass substrate 3 is coated with the mixture while changing the mixing ratio in the direction of the thickness of the resulting film. The amt. of the SiO2 particles 2 is gradually reduced from the surface of the substrate toward the surface of the film and the malt of the MgF2 particles 1 is gradually increased. The change of refractive index at the interface between the film and the glass substrate is made gradual, a significant antireflection effect is produced and an antireflection film of a large area is formed at a low cost.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑲ 日本 国 特 許 庁 (JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-245702

®Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)10月1日

G 02 B 1/10

A 8106-2H

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

図発明の名称 反射防止膜及びその製作方法

②特 頭 平1-66193

②出 願 平1(1989)3月20日

⑩発 明 者 岡 田 売 二 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

⑦発 明 者 遠 藤 喜 重 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

四発明者河村孝男千葉県茂原市早野3300番地株式会社日立製作所茂原工場

中央宗汉原中于19300番地 体式云征日立安作所及原工场内

@発 明 者 河 村 啓 益 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

⑦出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑩代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 割 費

発明の名称
反射防止膜及びその製作方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 超微粒子を主体とする反射防止膜において、 2 種類以上の超微粒子が混在し、膜厚方向にそ の混合比が変化することを特徴とする反射防止 膜。
 - 2. 超微粒子を主体とする反射防止機において、 2種類以上の超微粒子が混在し、その混合比が 異なる種間が2層以上形成されていることを特 徴とする反射防止機。
 - 3. 超微粒子を主体とする反射防止機の形成方法 において、2種類以上の超微粒子を混合し、そ の混合比が異なる神解を積削して機厚方向に超 微粒子の混合比を変化させることを特徴とする 反射防止機の製作方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は超微粒子版利用装置に係り、特に陰枢

線臂の反射防止睒として有効な脊漿に関する。 (従来の技術)

ガラス製面の反射率を低波する版(反射防止版) に関する研究は古く、カメラ・メガネなどのレン ズに利用されてきた。現在は、VDTの反射光を 低減するための反射防止フイルタなどに用いられ ている。反射防止版にはさまざまなものがあるが、 現在利用されているものは主に、多層版と不均質 版である。

多層膜とはガラス装面に低組折率物質、高組折率物質を交互に積層した構成であり、その反射防止効果は各層間での光学的干渉作用の総合効果である。多層膜に関してはフィヂツクス・オブ・スイン・フィルムの2号(1964年)第243項(Physics of Thin Films 2, (1964) P。243~P。284)から第284項に論じられている。

また、 数の 厚味方向に 屈折率分布を持つ 脚を 不均質 膜というが、 この 膜の 平均 屈折率 が 基板 ガラスよりも低い場合、 反射防止 脚となる。 不均質 膜

ではガラス表面を多孔質化したものが一般的である。ガラス表面に島状の金属蒸着膜を形成後、スパツタエツチングにより微細な凹凸を形成して不均質膜を作り、反射率を低減する方法がアツプライド・フイヂツクス・レター36号(1980年)の第727項から第730項(Appl.Phys.Lett,36(1980) P.727~P.730) において論じられている。また、ゾーダライムガラスをSiOz 遊戯和のHzSiFe溶液に浸せきし、表面を多孔質化して反射率を低減させる方法がソーラー・エネルギ、6号(1980年) の第28 項から第34項(Solar Energy 6(1980) P.28~P.34) において論じられている。

(発明が解決しようとする課題)

上記従来技術、多別数は形成方法がスパンタリング、真空素者法に限られ、かつ数厚の高報度制御が必要であるため、コストが高くかつ大面積化が難しいという問題があつた。スパツタエツチングによつて不均貨数を形成する方法も、コストが高くかつ大面積化が難しいという問題があつた。

そこで、ガラス基板とMgF1との中間の屈折率を持つ物質、例えばSiO1(屈折率1.46)の超微粒子とMgF1超微粒子を混合してガラス基板に強布し、その混合比を腹厚方向で変える、すなわちガラス基板での混合比を破らし、MgF1超微粒子の混合比を増すことで、独布し、MgF1超板との界面における屈折率変化がよりゆるやかとなり、有効な反射防止効果が図れる。また、本方法によつて、大面積の反射防止機を低コストで形成することができる。

〔作用〕

ガラス基板に近い屈折半を持つ物質(例えばSiO2)と空気に近い屈折半を持つ物質(例えば はMgF2)とを混合する際に超微粒子を用いることで、耐物質が光の波長より小さなレベルで均一に混合することができる。そのため、その屈が中はSiO2とMgF2との体積のは大変ないる。すなわち、SiO2超微粒子とMgF2超微粒子とを混合した超微粒子膜に

HaSiFe前被に漫せきし、製画を多孔質化して不均質膜を形成する方法は、微細な凹凸が形成し難く、十分な反射防止機能が生じない。また十分に微細な凹凸でないために、反射率とともに避過・ 本も低減するという問題があった。

本発明の目的は低コストでかつ、大面積化が容易な反射防止機を形成することにある。

〔醍題を解決するための手段〕

光の反射は屈折率が急変する界面で生じるため、逆に界面において屈折率が徐々に変化すれば反射は生じなくなる。通常、ソーダガラス(屈折率約1.53)の反射防止には、最も低反射率の物質フッ化マグネシウム(MgFz)(屈折率1.38)をスパッタ等によつて蒸着させているが、ガラスを板とMgFz 膜の界面、MgFz 膜と空気(屈折率約1.0)との界面で屈折率が急変するため反射防止効果は十分ではない。従つて、ガラス基板に近い屈折率から徐々に空気に近い屈折率へ変化する膜が形成できれば、有効な反射防止効果が得られる。

おいて、腹呼方向又の位置における平均的組折率n(x)は、同位置におけるSiOz 超微粒子の体積分率をV(s)とすると、n(x)=1・4 6×V(s)+1・3 8×{1-V(s)}と示せる。 従つて殿呼方向に混合比を変えれば組折率も対応して変化し、ガラス新板と強布膜との界面の風折率変化がゆるやかとなる。

また、混合比の異なる強布拠を積み重ねることで、概全体として平均的刷折率が徐々に変化する 概を形成することができる。

(実施例)

以下、本発明の実施例を第1回~第3回により裁明する。

第1 図は、ガラス基板上に本発明の組微粒子膜を形成した時の所面図であり、第2 図は前記組微粒子膜の膜厚方向に対する平均屈折率の変化を示す図である。

まず、エチルシリケート (Si(OC2H6)4)を エタノールに溶解し、さらに水、硝酸、イソプロ ピルアルコール、アセチルアセトンを加えた溶剤 に、SiO2 超微粒子を加えて超音波振動により十分に分散させた。SiO2 超微粒子の量は、上記審剤1 & に対して、2 5 g とした。SiO2 超微粒子分散後、さらにシトラコン酸を加え、十分に溶解させた。シトラコン酸の量は上記幣剤1 & に対して10 g とした。その後、さらに超音波振動を加えて、SiO2 超微粒子の十分な分散、各成分の十分な混合を図った。以上の混合を終えた溶剤を溶剤Aとする。

上記溶剤Aに、あらかじめMgF2 超微粒子、エチルシリケートをエタノールに分散しておいた溶剤Bを加え、超音波振動によつて均一に混合した。溶剤B中のMgF2 超微粒子はは溶剤1 g に対し、約25gである。溶剤Aと溶剤Bとの混合比を変えて、SiO2 超微粒子とMgF2 超微粒子の混合比を変える。

まず、SiO2 超微粒子とM 8 F 2 超微粒子の体積分率が7:3になるように溶剤Aと溶剤Bとを混合した溶剤をガラス板面上に溶下し、さらにスピンナーで均一に強布した後、空気中で40℃

はソーダガラスの屈折率で約1.53 である。 膜全体としては、屈折率が徐々に変化しているため、旅布膜とガラス基板との界面における反射率 を低減する効果がある。また、超微粒子によつて 膜を形成しているため、強布膜表面に微小な凹凸が生じ、強布膜表面での反射を低減する結果となっている。

上記の超微粒子概を形成したガラス基板と未処理のガラス基板に対して、5°の入射角度で波長400~700nmの光を入射させ、その反射率を測定し結果を第3回に示す。図中「が上記超微粒子概を形成したガラス板の反射特性であり、 I が未処理のガラス板の反射特性である。

全波及域において本発明の反射防止酸は未処理のガラス板の約1/4まで反射率が低減している。また透過率は、波及400~700 n m間の積分値で示すと、未処理ガラス板が92%に対して本発明の反射防止膜を形成したガラス板は約86%となる。可視光全領域で低反射であり、かつ透過率が高いため、VDT(ビジュアル・ディスプレ

に約10分間保つて上記強布膜を乾燥させた。乾燥後、さらにSiOュ組微粒子とMgFュ 組微粒子の体税分率が1:1になるように混合した溶剤を消下し、スピンナーで均一に強布した。その後、160℃で45分間空気中で焼成し、エチルシリケートを熱分解してSiOュ 化した。MgFュ 超微粒子、SiOュ 超微粒子は熱分解で生じたSiOェによつてガラス基板上に強固に固着される。

このようにして形成した超微粒子膜の断面をは子顕微鏡で観察したところ、第1回に示すようにSiO2 超微粒子とMgF2 超微粒子が7:3となる別(第1周)が約0.1 μm , 1:1となる別(第2別)が約0.1 μmで計約0.2 μm 膜厚の、SiO2 超微粒子, MgF2 超微粒子が均一に混合して、衡に堆積した膜が観察された。

上記の超微粒子版の、腹厚方向に対する平均組 折率の変化をSiOz組微粒子とMgFz組微粒子 の体積分率から算出した結果を第2図に示す。 a は空気の屈折率で約1.0 、bは第1層の屈折率 で約1.42、cは第2層の屈折率で約1.44、

イ・ターミナル)に対する反射防止膜として好適 である。

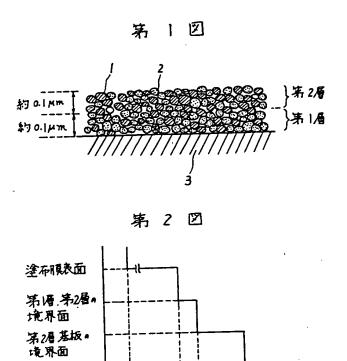
なお、本実施例では混合比を変えた2 別としたが、より多別として平均周折率の変化をより小刻みとすれば反射防止効果は一別増すこととなる。 (発明の効果)

本発明によれば、簡単な強布法をくり返すことで屈折率が連続変化した膜を形成できるため、反射防止膜を低コストで製造できる、さらに大面積の反射防止膜も容易に形成できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の反射防止機の断面 図、第2図は上記反射防止膜の膜厚方向に対する 屈折率の変化を示した図、第3図は本発明の一実 施例の反射防止膜と未処理ガラス板との波長400 ~700 n m 間の反射率を示す特性図である。 1 … M g F 2 超微粒子、2 … S i O 2 超微粒子、3 … ガラス基板。

代理人 弁理士 小川腳男



平均屈折率

